Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	<u>Диоды</u>		
VD2, VD3	15SQ045 (Dongguan YFW, Kumaū)	2	
VD1	1N4002 (Diotec Semiconductor, Германия)	1	
	<u>Конденсаторы</u>		
<i>C</i> 4	К10-17Б 1000пФ 50В ±5% (Murata Electronics, Япония)	1	
С1	К10-17Б 220пФ 50В ±5% (Murata Electronics, Япония)	1	
С7	K73-17 0,68mκΦ 250B ±5%	1	
	(Кузнецкий завод конденсаторов, Россия)		
<i>[6, [8</i>	К50-35 2200мкФ 35B ±20% (JB Capacitors, Гонконг)	2	
С2, С5	K50-35 мини 47мкФ 50B ±20% (JB Сарасitors, Гонконг)	2	
<i>[3</i>	К50-35 100мкФ 63B ±20% (JB Capacitors, Гонконг)		
	<u>Разьёмы</u>		
XS1	Гнездо стерео 3,5мм ST-025	1	
	(Dragon City Industries, Kumaū)		
XP1	Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-03P (Degson, Kumaū)	1	
XP2	Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-02P (Degson, Kumaū)	1	
	<u>Резисторы</u>		
R14, R15	CF-25 0,25Bm 4.7κ0m ±5%	2	
R3, R5	CF-25 0,25Bm 6800m ±5%	2	
R12, R13	CF-25 0,25Вт ЗкОм ±5%	2	
R11	CF-25 0,25Вт 15кОм ±5%	1	
Изм Лист N° č	ИУ4.11.03.03.23.05.5. Вокум Подп. Дата	2.04	4.001 ПЭЗ
Разраб. Бакуле Пров. Семенцо	//	Λu	ит. Лист Листов 1 2
Н. контр. Утв.	НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ Перечень элементов		ТУ им Н.Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4 — 52Б

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
<i>R7</i>	CF-25 0,25Bm 1,2κ0м ±5%	1	
R14	CF-25 0,25Bm 2κ0м ±5%	1	
R18	CF-100 1Bm 100m ±5%	1	
R4	CF-100 1Bm 15x0m ±5%	2	
R6, R17	SQP 5Bm 0,10m ±5%	2	
RP1	3296W-1-1-2LF 0,25Bm 1кОм ±20% (Bourns, США)	1	
	<u>Транзисторы</u>		
VT3, VT4, VT6	BC546B (Diotec Semiconductor, Германия)	3	
VT1, VT2, VT5	BC556B (Diotec Semiconductor, Германия)	3	
VT7	IRF540NPBF (Infineon Technologies, Германия)	1	
VT8	IRF9540NPBF (Infineon Technologies, Германия)	1	
	MILL 11 02 02 22 05 52 1		Лисп

Изм Лист № докум. Подп. Дата

ИУ4.11.03.03.23.05.52.04.001 ПЭ 3

/lucm